

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成26年7月17日(2014.7.17)

【公開番号】特開2012-28758(P2012-28758A)

【公開日】平成24年2月9日(2012.2.9)

【年通号数】公開・登録公報2012-006

【出願番号】特願2011-137590(P2011-137590)

【国際特許分類】

H 01 L 21/66 (2006.01)

H 01 L 29/786 (2006.01)

H 01 L 21/336 (2006.01)

【F I】

H 01 L 21/66 H

H 01 L 29/78 6 2 4

H 01 L 29/78 6 1 8 B

【手続補正書】

【提出日】平成26年5月30日(2014.5.30)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

トランジスタの信頼性を評価する検査方法であって、

前記トランジスタに光を照射しながら、前記トランジスタのゲート電極とソース電極との間の電圧をV_gとし、前記トランジスタのドレイン電極とソース電極との間の電流をI_dとした前記トランジスタのI_d-V_g曲線におけるヒステリシス特性を解析することを特徴とする半導体装置の検査方法。

【請求項2】

トランジスタを作製し、

前記トランジスタに光を照射しながら、前記トランジスタのゲート電極とソース電極との間の電圧(V_g)を変化させたときの、前記トランジスタのドレイン電極とソース電極との間の電流(I_d)を測定して得られる前記トランジスタのI_d-V_g曲線を用いて良否判定の検査を行い、

前記トランジスタを用いて半導体装置を作製する半導体装置の作製方法。

【請求項3】

請求項2において、

前記トランジスタは、酸化物半導体層を有する半導体装置の作製方法。